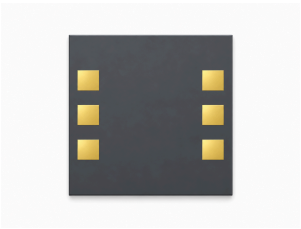
8000–12000 MHz GaAs-Flankenentzerrerchip

LCEQ-8000-12000-D — 8000–12000 MHz GaAs-Flankenentzerrerchip.

Entzerrungsbetrag: 2 dB; Einfügedämpfung @ 8000 MHz: 2.6 dB;
Einfügedämpfung @ 12000 MHz: 0.7 dB. Chipabmessungen: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.



RF-Kennwerte

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Betriebsfrequenz	-	8000	-	12000	-	MHz
Entzerrungsbetrag	-	-	-	-	2	dB
Einfügedämpfung @ 8000 MHz	-	-	-	-	2.6	dB
Einfügedämpfung @ 12000 MHz	-	-	-	-	0.7	dB
Ein-/Ausgangs-VSWR	-	-	-	-	1.2	-

Grenzwerte

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Eingangsleistung	-	-	-	30	dBm

Umgebungsbedingungen

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Betriebstemperatur	-	-55	-	125	°C

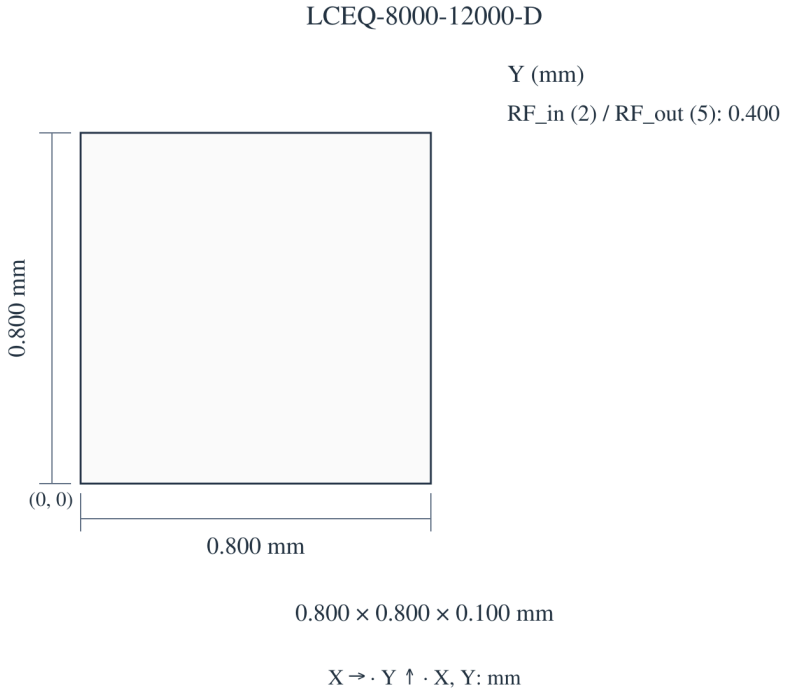
Bondpad-Belegung

Anschlüsse	Symbol	Funktion	Hinweise
1, 3, 4, 6	GND	Masse	-
2	RF_in	RF-Eingang	-
5	RF_out	RF-Ausgang	-

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen	0.8 × 0.8 × 0.1	mm

Maßskizze mit ausgewählten Abmessungen in mm. Für Fertigung und Drahtbonden sind vollständige Zeichnungen erforderlich.



Aktueller Publikationsstand · 1.6 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.5.

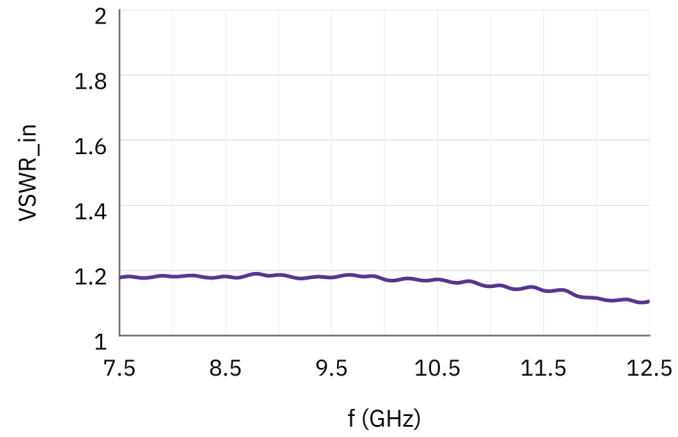
Kennlinien

Beachten Sie die bei jeder Abbildung angegebenen Betriebsbedingungen.

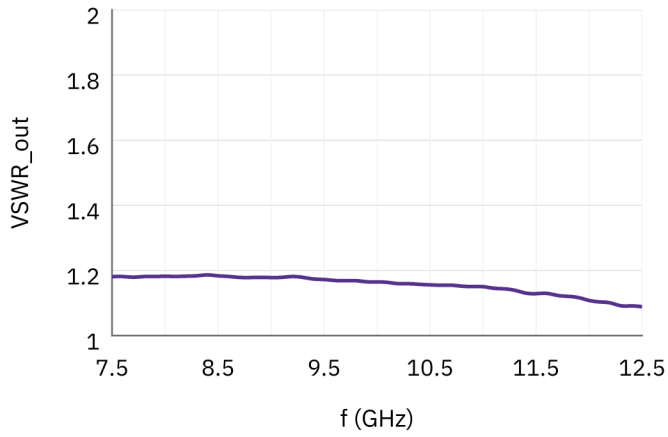
Eingangsanpassung; Ausgangsanpassung; Einfügedämpfung; Phasenverschiebung.

Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte. Die Ordinate ist mit P bezeichnet. Eine Phaseneinheit ist nicht angegeben.

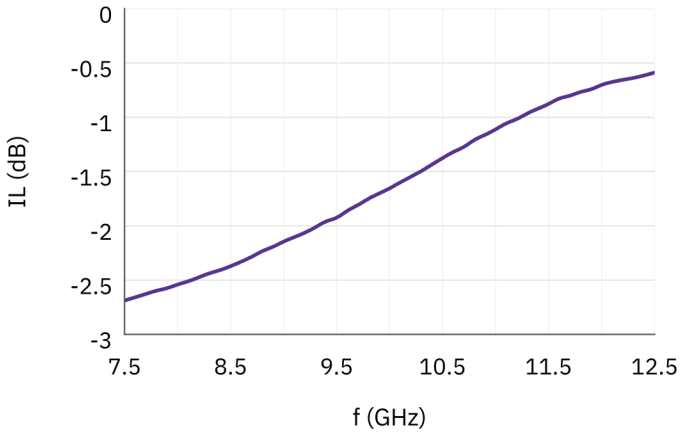
VSWR-in



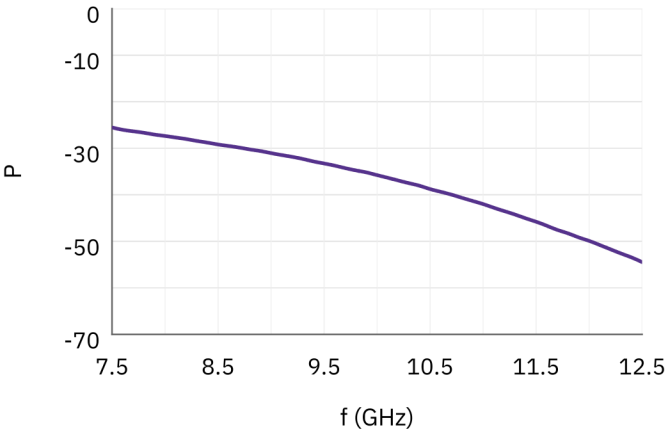
VSWR-out



IL



P



Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.